

中国电子科技集团公司第十三研究所



性能特点

- 宽频带: 1.0~4.0GHz
- ●输出功率Po: 20dBm
- ●良好的50Ω阻抗匹配,易于级联使用
- 微波薄膜电路结构, 电性能稳定可靠
- 采用标准全密封管壳封装
- 满足军温工作条件: -55℃~+85℃

电性能表(50Ω测试系统,V_{cc}=+12V,T_s=-55℃~+85℃)

性能参数	符号	单位	规范值	典型值
频率范围	$f_{\scriptscriptstyle L}{\sim}f_{\scriptscriptstyle H}$	GHz	1.0~4.0	1.0~4.0
小信号功率增益	Gp	dB	≥ 24. 0	25. 0
增益平坦度	ΔGp	dB	≤±1.0	±0.6
噪声系数	Fn	dB	≤3.0 ∆	2. 5
输入驻波比	VSWRi		≤2.0:1	1.7:1
输出驻波比	VSWRo		≤ 2.0:1	1.7:1
输出功率	Ро	dBm	≥ 20.0 * ∆	21.0
工作电流	${ m I}_{ m cc}$	mA		100

注: "*" f =4000MHz; 规范值中带"Δ"的参数为常温参数。

极限参数

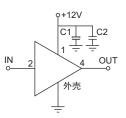
最高电源电压: +13.5Vpc 最大输入功率: +13dBm 最高储存温度: +125℃



使用说明

- 1. 电路按右图连接,内部集成有耦合电容, $C_1 = 3.3 \sim 22 \mu F$, $C_2 = 3300 \sim 6800 pF$;
- 2. 静电敏感电路,使用中注意防静电;
- 3. 可提供盒体结构(SMA输出)SMA-1封装 类型的产品;
- 4. 外形尺寸和安装使用方法见本册附后 的《封装外形尺寸及安装使用说明》页。
- 5. 本电路直流功耗大,使用中注意散热。





典型曲线

